## 科学研究費助成事業

研究成果報告書

平成 30 年 4 月 3 0 日現在 機関番号: 14401 研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2015~2017 課題番号: 15K13406 研究課題名(和文)細孔構造ゼオライトへのインジウム注入技術開発と超高効率新規反応触媒実現への応用 研究課題名(英文)Indium implantations onto porous zeolites for the development of novel catalysts 研究代表者 吉村 智 (Yoshimura, Satoru) 大阪大学・工学研究科・准教授

研究者番号:40294029

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 1,800,000円

研究成果の概要(和文):近年、インジウムとケイ素を組み合わせた触媒が注目されている。ゼオライトはケイ 素を含有する細孔構造粉末である。そのため、ゼオライトにインジウムを担持できれば、高効率などの特長を持 った触媒が実現する可能性がある。本研究では、イオンビーム法、およびアークプラズマ法により、ゼオライト にインジウムを担持した触媒の合成に取り組んだ。製作したサンプルを分析した結果、アークプラズマ法を用い て製作したサンプルがFriedel-Crafts反応に対して触媒活性を持つことが明らかになった。また、最適な触媒効 果を得るには、粒径の小さなインジウムを適度に分散してサンプル上に担持する必要があることが明らかになっ た。

研究成果の概要(英文): In previous papers, it has been reported that chemical substances that contain both indium (In) and silicon (Si) in close proximity catalyze certain organic chemical reactions. In this study, the implantation of In onto zeolite was carried out by an ion beam injection process or by an arc plasma process for the possible development of novel catalysts. In the ion beam experiment, In ions were generated by sputtering of In203 target with Ar ions in an ion source. In ions were extracted under high voltages to form mono-energic In ions with the peak energy of 500 eV. Then, the zeolite substrates were irradiated with the In ion beam. XRD and XPS of samples reveals that In was successfully implanted. However, we failed to detect the catalytic effects. On the other hand, In nanoparticles were deposited on zeolite using a pulse arc plasma system. We have found that the resulting materials were capable of catalyzing an organic chemical reaction, i.e., Friedel-Craft alkylation.

研究分野: プラズマ科学

キーワード: インジウム ゼオライト 触媒 イオンビーム プラズマ



### 1.研究開始当初の背景

近年、インジウムは多くの産業分野で利用 されている。化学分野では、インジウムとケ イ素を組み合わせた新しい触媒(複合系金属 種の協同的作用に基づく触媒)が最近発見さ れた[1-3]。従来の研究では、こうした触媒 は化学的な手法により合成されてきた。一方 我々は、物理的な手法によりこの種の触媒を 合成する研究を行ってきた。本研究課題を開 始する以前には、酸化ケイ素基板にインジウ ムイオンビームを照射し、インジウムを基板 に注入することにより、触媒能を発現させる ことに成功している[4-6]。金属インジウム および酸化ケイ素単体は、ともに触媒能がな いので、この結果は、インジウムとケイ素の 相互作用により発現したものと考えている。

2.研究の目的

この発見の次の発展として、3次元的な細 孔構造を持つ粉体試料(メソポーラスシリカ やゼオライトなど)にインジウムを担持し、 ここでインジウム/ケイ素の相互作用を実現 すれば全く新しい反応系を実現できると考 えた。そこで本研究では、イオンビーム技術 またはプラズマ技術を用いることにより、ケ イ素を含有する粉体試料に対してインジウ ムを注入して触媒の合成を試みる研究に取 り組むことにした。

本研究では、実験のターゲットとしてゼオ ライトを用いた。ゼオライトはケイ素を含有 する粉末で、分子レベルで蜂の巣状に3次元 に連結する細孔構造を持っており、その内部 比表面積は大きい。そのため、ゼオライトに インジウムを担持し、上記のようなインジウ ムとケイ素の相互作用を発現させることが できれば、高効率などの特長を持った新しい タイプの触媒が実現する可能性がある。さら に、反応終了後の触媒回収が容易、再利用可 能、などといった利点も期待できる。ゼオラ イトにインジウムを担持するという研究自 体は他の研究グループでも行われており、複 数の論文がすでに出版されている。しかしな がら、過去の研究はいずれも化学的手法によ る合成であり、我々のように、イオンビーム 技術やプラズマ技術のような物理的手法を この種の触媒合成に使った例はまだない。

本研究では、研究代表者の持つイオンビー ム技術およびプラズマ技術を活用し、また研 究協力者(表面科学研究者、有機化学研究者) と連携し、インジウム担持ゼオライト触媒を 開発すること、および得られた触媒の特性評 価を行うことを研究目的とした。

### 3.研究の方法

本研究では、低エネルギー質量分離イオン ビーム照射装置を用いる。我々は、本装置の フリーマン型イオン源に改造を加え、内部に スパッタターゲットを取り付けられるよう にした。スパッタリングの促進のため、ター ゲットには-500Vのバイアス電圧を印加した。

インジウムイオンビームは、以下に示す手順 で生成する。まず、イオン源のアークチャン バ内にアルゴンガス(約1sccm)を導入し、 ここでアルゴンプラズマを発生させる。アル ゴンプラズマでターゲットの酸化インジウ ムをスパッタリングし、アークチャンバ内に インジウムイオンを生成する。チャンバ内の イオンは、高電圧(-15kV)により引き出さ れる。高精度の質量分離器を介してアルゴン や酸素など不純物イオンが完全に取り除か れ、インジウムイオンのみが選択される。こ うして得られたインジウムイオンビームは、 集束された後に所望のエネルギー(10~ 500eV の範囲で可変) に減速され、成膜チャ ンバ内に配置された基板に照射される。成膜 チャンバ内の概略図を Fig. 1 に示す。成膜 チャンバには、基板の帯電中和用電子銃と質 量-エネルギー分析器が設置されている。

本研究では、以下の手順で実験を行う。ま ず、質量分離後のイオンビームの分析を行い、 実際にインジウムイオンビームが得られて いることを確認する。また、そのエネルギー スペクトルを測定する。こうして得られたイ ンジウムイオンビームをゼオライト基板に 注入する実験を行う。なお、市販されている ゼオライトは粉末状でありイオンビーム実 験のターゲットとしては不向きであるので、 プレスによりイオンビーム実験のターゲッ トとして利用可能な基板状に加工した。イン ジウムイオンの照射総量(ドーズ量)は、イ オンビームの電流量と照射時間から求める ことができる。今回は、入射イオンのエネル ギーは約500 eVとし、ドース量の異なる3個 のサンプルを作製した。また、これらのサン プルの表面分析を行った。最後に、サンプル の触媒特性の評価を行った。



Fig. 1 イオンビーム装置の成膜チャンバ

#### 4.研究成果

まず、イオンビーム入射用のゼオライトタ ーゲットの形成方法に関して検討を行った。 今回の実験で使用するゼオライトとしては、 SIGMA-ALDRICH 社製の Molecular sieves 5 を選択した。これは粉末状であるため、我々 の装置でのイオンビーム実験のターゲット として用いるのは、そのままの状態では困難 であり、固形ターゲットに成形する必要があ る。そこで、プレスでペレット状に加工した。 これを基板ホルダーに貼付して成膜チャン バ内にセットし、チャンバの真空引き試験を 行った。通常のチャンバ内の真空度は 5x10<sup>-7</sup> Pa 程度であるが、このターゲットをチャンバ 内に入れると真空度は 5x10<sup>-6</sup> Pa 程度になっ た。このように真空度は悪化したが、イオン ビーム入射実験は可能なレベルに収まった。





次に、イオンビームを分析した。結果を Fig. 2 に示す。Fig. 2(a)は、イオンビームの質量 スペクトルである。ピークが質量数 115 の箇 所にあることから、このイオンがインジウム であることが確かめられた。また、インジウ ム以外の不純物イオンは含まれていないこ とが分かった。Fig. 2(b)にはエネルギース ペクトルを示している。

照射時間を変えることにより、ドース量の 異なるサンプル(a)-(d)を作成した。ドース 量は、(a)ゼロ(インジウム入射なし) (b) 6.6x10<sup>16</sup>、(c)1.2x10<sup>17</sup>、(d)2.5x10<sup>17</sup> ions と した。

これらのサンプルをX線回折装置により 分析した。サンプル(a)-(d)の回折パターン をFig. 3(a)-(d)にそれぞれ示す。Fig. 3(a) の各ピークは、Molecular sieves 5 に起因 するものである。Fig. 3(b)と(c)には、イン ジウムイオンドース量の比較的少ない2つ のサンプル(b)と(c)のスペクトルを示して いる。Fig. 3(b)と(c)のスペクトルは Fig. 3(a)と類似している。このように、サンプル (b)と(c)ではゼオライト由来のピークのみ が観測され、インジウム由来のピークは見つ からなかった。一方、インジウムドース量の 一番多いサンプル(d)には、Fig. 3(d)に矢印 で示したように、インジウム由来の回折ピーク(In(111))が見つかった。



Fig. 3 サンプルの X 線回折パターン

最後に、サンプル(b)-(d)の触媒効果を調 べた。今回は、benzhydrol と acetylaceton 間の炭素 - 炭素結合形成反応について検証 したが、サンプル(b)-(d)のいずれの場合に も触媒能は観測されなかった。反応が進行し なかった原因は明らかにはなっていないが、 インジウムの担持量がまだ不十分であった 可能性がある。そこで、ドース量をさらに増 やすことを検討したが、今回用いたイオンビ ーム装置のビーム電流はそれほど大きくな いため、ドース量を十分なレベルまで増やす には、実験時間を過度に長くする(例えば1 か月)必要があるとわかった。

そこで、アークプラズマ法ナノ粒子形成装置(ADVANCE RIKO, APD-P)を用いた実験も 平行して実施することにした。この装置は、 コンデンサに蓄えた電荷をパルス的に瞬時 に放電させることによりアークを発生させ、 ターゲット材料(今回はインジウム)のナノ 粒子形成ビームを生成するものである。生成 されるナノ粒子のサイズは、用いるコンデン サの容量に依存し、1~10nm 程度になる。プ ラズマを用いる方法は十分なドース量を得 ることが容易であるだけでなく、イオンビー ムを用いる方法に比べて低コストでより多 くのサンプルを製作することが可能と考え られる。

本装置により生成したインジウムナノ粒 子は、装置下部に配置したターゲットに向け て照射される。今回は、ターゲットとして、 粉末状のゼオライト(20mL)を、そのままの 状態で円筒形の容器に収めて配置した。容器 内のゼオライトを攪拌(50rpm)することに より、個々のゼオライト粉末にほぼ均一にイ ンジウムを照射できる。照射されるインジウ ムのエネルギーは 35eV である。

サンプルに担持されるインジウムの重量 は、放電回数によって制御できる。最初の実 験では、サンプル中のインジウム重量が全重 量の 0.4%となるように放電回数を設定した。 また、コンデンサ容量が 360 µF と 1080 µF の 2 つの場合について実験を行った。以下で は、サンプル(a):未処理のゼオライト、サ ンプル(b): 360 µF で製作したインジウム担 持ゼオライト、サンプル(c): 1080 µF で製作 したインジウム担持ゼオライト、とする。



Fig. 4 サンプルの SEM 写真

ゼオライト表面でのインジウムの担持状 態を見るために、サンプル(a)-(c)を透過電 子顕微鏡(TEM)で観察した。しかしながら、 TEM では高エネルギーの電子線を用いるため、 電子線がサンプルに与えるダメージが大変 大きく、汎用型の TEM 装置ではゼオライトの 測定は困難であることが分かった。次に、走 査型電子顕微鏡(SEM)を用いて観察した。電 子線によるサンプルのダメージを極力減ら すため、今回は加速電圧を 800V と低めの値 にした。サンプル(b)の SEM 写真にはインジ ウム粒子らしき構造を全く見ることができ なかった。ほぼ同様に、サンプル(c)におい てもインジウムらしき担持物はほとんどの 箇所で見ることができなかったが、インジウ ムと思われる粒子群(径:5-20nm 程度)がゼ オライト表面に局所的に凝集している場所 がいくつかあることが分かった。その部分の 写真を Fig. 4 に示す。

これらのサンプルについても benzhydrol と acetylaceton 間の炭素 - 炭素結合形成反 応について触媒効果を検証したが、この反応 に関しては、触媒効果は観測されなかった

インジウム系の物質が触媒として機能す る化学反応は、benzhydrol と acetylaceton 間の反応以外にもいくつか報告がある。例え ば、Friedel-Crafts 反応や向山アルドール反 応が挙げられる。今回検討した benzhydrol と acetvlaceton 間の反応よりも、これらの 反応は進行し易いために、インジウム - ゼオ ライト触媒が成立するのに有利と思われる。 そこで、イオンビーム装置を用いて製作した サンプルおよび APD-P 装置を用いて製作した サンプルについて、これらの反応に対して触 媒効果を有するか否かを検証する実験を行 った結果、APD-P 装置を用いて製作したサン プルが benzhydryl chloride と anisole の間 の Friedel-Crafts 反応に対して触媒活性を 持つことが明らかになった[7]。

次に、触媒効果を得るのに最も適切なイン ジウム照射量を明らかにするため、221,735, 2204, 4408, 7346, 11754, 22040の7通りの 放電回数でサンプルを作成した(コンデンサ 容量は360 µ F に固定)。サンプルに担持され たインジウムの重量は、照射後のサンプル全 重量の 0.009, 0.03, 0.09, 0.2, 0.3, 0.5, 0.9wt%である。触媒特性の測定を行った結果、 0.2, 0.3, 0.5, 0.9wt%のサンプルにおいて、 Friedel-Crafts 反応に対しての触媒活性が はっきりと確認できた[8]。また、触媒効率 はインジウム量の増加とともに増大するが、 0.5wt%の場合に最大になり、0.9wt%の場合に は触媒効率が低下してしまうことも明らか になった。サンプル表面の分析により、 0.5wt%までの場合には、インジウムは数 nm 以下のサイズで分散してサンプル上に存在 しているが、0.9wt%の場合にはインジウムが 凝集して大きな粒で存在していることがわ かった。これが、0.9wt%のサンプルで触媒効 果が低減した理由ではないかと考えている。 この結果から、最適な触媒効果を得るには、 粒径の小さなインジウムを適度に分散して サンプル上に担持する必要があることが明 らかになった。

< 引用文献 >

[1] Y. Onishi, et al., Eur. J. Org. Chem., (2002) 1578.

[2] T. Saito, et al., Synlett, (2005) 1737.
[3] U. Schneider, et al., Angew. Chem. Int.
Ed., 46 (2007) 5909.

[4] S. Yoshimura, et al., Appl. Surf. Sci.,257 (2010) 192.

[5] S. Yoshimura, et al., Thin Solid Films, 520 (2012) 4894.

[6] S. Yoshimura, et al., Nucl. Instr. Methods Phys. Res. B, 315 (2013) 222.

[7] S. Yoshimura, et. al., Chem. Lett., 44

(2015) 1292.[8] S. Yoshimura, et. al., AIP Adv., 7(2017) 065117.

# 5.主な発表論文等 〔雑誌論文〕(計6件)

<u>S. Yoshimura</u>, Y. Nishimoto, S. Sugimoto, <u>M. Kiuchi</u>, M. Yasuda, Deposition of indium nanoparticles on powdered material by pulse arc plasma to synthesize catalysts for Friedel-Crafts alkylation, e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, 査 読有, Vol. 16, 2018, pp.105-110. DOI: 10.1380/ejssnt.2018.105

<u>S. Yoshimura</u>, Y. Nishimoto, <u>M. Kiuchi</u>, Y. Agawa, H. Tanaka, M. Yasuda, Catalytic property of an indium-deposited powder-type material containing silicon and its dependence on the dose of indium nano-particles irradiated by a pulse arc plasma process, AIP Advances, 査読有, Vol. 7, No. 6, 2017, 065117-1-9.

DOI: 10.1063/1.4990517

<u>S. Yoshimura</u>, S. Sugimoto, K. Murai, <u>M.</u> <u>Kiuchi</u>, Low-energy mass-selected ion beam production of fragments produced from hexamethyldisiloxane for the formation of silicon oxide film, Surface and Coatings Technology, 査読有, Vol. 313, 2017, pp. 402-406.

DOI: 10.1016/j.surfcoat.2017.02.009

<u>S. Yoshimura</u>, S. Sugimoto, K. Murai, <u>M.</u> <u>Kiuchi</u>, Low-energy  $SiC_2H_6^+$  and  $SiC_3H_9^+$  ion beam productions by the mass-selection of fragments produced form hexamethyldisilane for SiC film formations, AIP Advances, 査読有, Vol. 6, No. 12, 2016, 125029-1-6.

DOI: 10.1063/1.4972206

<u>吉村智</u>,<u>木内正人</u>,西本能弘,安田誠, 馬場章夫, 李野由明,杉本敏司,浜口智志, 新規反応触媒開発を目指したゼオライトへ のインジウム担持の試み,スマートプロセ ス学会誌,査読有, Vol. 4, No. 5, 2015, pp. 228-233.

<u>S. Yoshimura</u>, Y. Nishimoto, <u>M. Kiuchi</u>, M. Yasuda, Indium implantation onto zeolite by pulse arc plasma process for the development of novel catalysts, Chemistry Letters, 査読有, Vol. 44, No. 10, 2015, pp. 1292-1294.

DOI: 10.1246c1/150499

〔学会発表〕(計3件)

S. Yoshimura, Y. Nishimoto, S. Sugimoto, Kiuchi, Μ. Yasuda, Indium Μ. zeolite nano-particles deposition to powder by a pulse arc plasma process for synthesizing catalysts, The 8th International Symposium on Surface

Science (ISSS-8), 22-26 October, 2017, Epochal Tsukuba, Tsukuba, Japan.

<u>吉村智</u>, 西本能弘, <u>木内正人</u>, 安田誠, イ ンジウム担持ゼオライト触媒活性のインジ ウムドース依存性, 第 77 回応用物理学会秋 季学術講演会(2016年9月13-16日, 新潟朱 鷲メッセ)

<u>吉村智</u>, 西本能弘, <u>木内正人</u>, 安田誠, ゼ オライトへのインジウム担持とその触媒活 性, 第 76 回応用物理学会秋季学術講演会 (2015 年 9 月 13-16 日, 名古屋国際会議場)

6.研究組織

(1)研究代表者
 吉村 智(YOSHIMURA, Satoru)
 大阪大学・大学院工学研究科・准教授
 研究者番号:40294029

(2)研究分担者

木内 正人(KIUCHI, Masato) 国立研究開発法人産業技術総合研究所・材 料・化学領域 無機機能材料研究部門・主任 研究員

研究者番号: 50356862 平成28年3月18日以後は研究協力者